产品分类目录

射频衰减、检波与功率监测

按电平控制任务、波形、动态范围、响应时间、定向取样、功率、校准和保护边界设计射频衰减、检波与监测链路。

产品: 41

版本: 17 · 修订日期: 2026-11-12



RF 限幅器



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值) / 0.7 dB (最大值); 限幅电平: 16.5 dBm (典型值) / 17.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 43 dBm (最大值) (τ = 1 ms; D = 20%). 裸片尺寸: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

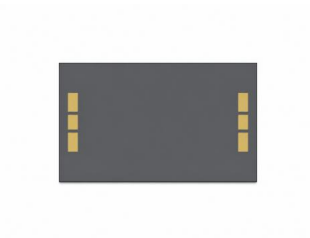
插入损耗: 典型值: 0.6; 最大值: 0.7; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.45 dB (典型值) / 0.5 dB (最大值); 限幅电平: 18.5 dBm (典型值) / 19.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 49 dBm (最大值) (τ = 2 ms; D = 20%); 最大脉冲输入功率: 50 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

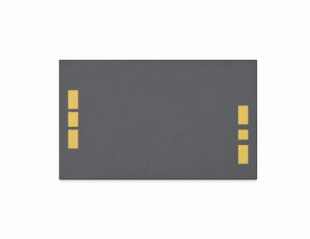
插入损耗: 典型值: 0.45; 最大值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.5 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 42 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

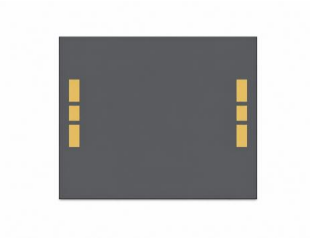
插入损耗: 典型值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值) / 0.4 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 43 dBm (最大值) (τ = 200 µs; D = 20%). 裸片尺寸: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

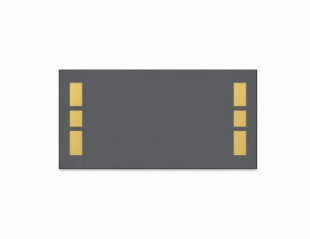
插入损耗: 典型值: 0.3; 最大值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4

输出驻波比: 典型值: 1.4

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 16.5 dBm (典型值) / 17.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 42 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

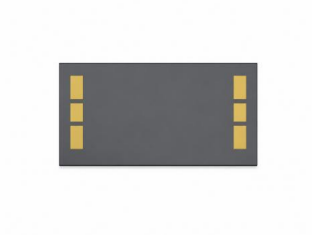
插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6

输出驻波比: 典型值: 1.6

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 41 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.6; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 48 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%); 最大输入功率: 46 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.4 dB (典型值) / 0.5 dB (最大值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大输入功率: 37 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 14000; 数值: DC–14000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.4; 最大值: 0.5; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.6 dB (典型值) / 0.7 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.6; 最大值: 0.7; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6

输出驻波比: 典型值: 1.6

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 37 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.3; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.3 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 37 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.3; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.2; 最大值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.8 dB (典型值); 限幅电平: 17 dBm (典型值) / 18 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 200 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 10000; 最大值: 18000; 数值: 10000–18000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.8; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.6; 最大值: 1.8

输出驻波比: 典型值: 1.6; 最大值: 1.8

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.35 dB (典型值) / 0.4 dB (最大值); 限幅电平: 15 dBm (典型值) / 16 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 45 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 6000; 数值: DC–6000; 单位: MHz

插入损耗: 典型值: 0.35; 最大值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.4; 最大值: 1.5

输出驻波比: 典型值: 1.4; 最大值: 1.5

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

插入损耗: 0.4 dB (典型值); 限幅电平: 16 dBm (典型值) / 17 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 51 dBm (最大值) (τ = 100 µs; D = 10%); 最大输入功率: 48 dBm (最大值) (CW). 裸片尺寸: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 2000; 最大值: 4000; 数值: 2000–4000; 单位: MHz

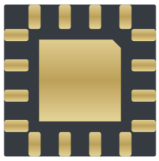
插入损耗: 典型值: 0.4; 单位: dB

输入驻波比: 典型值: 1.3

输出驻波比: 典型值: 1.3

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-12000-18000-PIP43U

12000–18000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%

12000–18000 MHz; 插入损耗 1.2 dB (典型值); 限幅电平 16 dBm (典型值); 输入耐受功率 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 12000; 最大值: 18000; 数值: 12000–18000; 单位: MHz

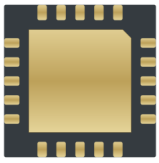
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1.2; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 16; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 43 (PW = 1 ms; D = 20%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-5000-6000-PIP49U

5000–6000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%

5000–6000 MHz; 插入损耗 0.9 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 5000; 最大值: 6000; 数值: 5000–6000; 单位: MHz

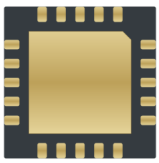
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 0.9; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 15; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 49 (PW = 2 ms; D = 20%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP42U

8000–12000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%

8000–12000 MHz; 插入损耗 0.9 dB (典型值); 限幅电平 14 dBm (典型值); 输入耐受功率 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

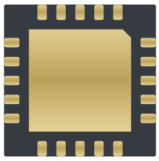
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 0.9; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 14; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 42 (PW = 4 ms; D = 20%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-2000-6000-PIP43U

2000–6000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%

2000–6000 MHz; 插入损耗 0.6 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 2000; 最大值: 6000; 数值: 2000–6000; 单位: MHz

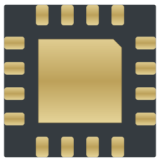
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 0.6; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 15; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 43 (PW = 200 µs; D = 20%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP42U

6000–18000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; 插入损耗 1.3 dB (典型值); 限幅电平 17 dBm (典型值); 输入耐受功率 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

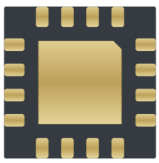
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1.3; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 17; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 42 (PW = 300 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-6000-18000-PIP41U

6000–18000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; 插入损耗 1.2 dB (典型值); 限幅电平 17 dBm (典型值); 输入耐受功率 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 6000; 最大值: 18000; 数值: 6000–18000; 单位: MHz

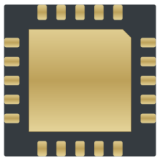
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1.2; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 17; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 41 (PW = 300 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP48U

8000–12000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; 插入损耗 1.2 dB (典型值); 限幅电平 16 dBm (典型值); 输入耐受功率 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

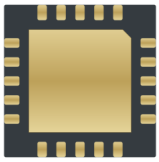
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1.2; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 16; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 48 (PW = 300 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-8000-12000-PIP45U

8000–12000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; 插入损耗 1 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 8000; 最大值: 12000; 数值: 8000–12000; 单位: MHz

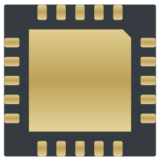
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 15; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-1000-6000-PICW46U

1000–6000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 46 dBm; CW

1000–6000 MHz; 插入损耗 0.8 dB (典型值); 限幅电平 16 dBm (典型值); 输入耐受功率 46 dBm; CW.

工作频率: 符号: f; 最小值: 1000; 最大值: 6000; 数值: 1000–6000; 单位: MHz

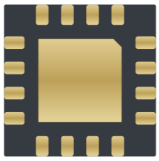
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 0.8; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 16; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 46 (CW); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-10000-18000-PIP45U

10000–18000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%

10000–18000 MHz; 插入损耗 1.4 dB (典型值); 限幅电平 17 dBm (典型值); 输入耐受功率 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: 10000; 最大值: 18000; 数值: 10000–18000; 单位: MHz

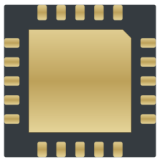
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 1.4; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 17; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 45 (PW = 200 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-6000-PIP45U

DC–6000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

DC–6000 MHz; 插入损耗 0.65 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 6000; 数值: DC–6000; 单位: MHz

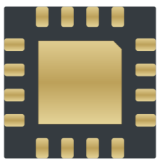
插入损耗: 符号: IL; 典型值: 0.65; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 15; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 数值: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCI-LIM-DC-14000-PICW37T

DC–14000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 37 dBm; CW

DC–14000 MHz; 插入损耗 0.5 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 37 dBm (典型值); CW.

工作频率: 符号: f; 最小值: DC; 最大值: 14000; 数值: DC–14000; 单位: MHz

插入损耗: 符号: IL; 最小值: 0.1; 典型值: 0.5; 最大值: 0.65; 单位: dB

限幅电平: 符号: PLim; 典型值: 15; 单位: dBm

输入耐受功率: 符号: Pp; 典型值: 37; 数值: CW; 单位: dBm

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

固定衰减器



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.2 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.2

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 4 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 4; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 16 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 16; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 0 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.6 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 0; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.6; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 1 dB; 输入/输出驻波比: 1.4 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 1; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.4

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 2 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 2; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 3 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 3; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 5 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 5; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 6 dB; 输入/输出驻波比: 1.35 ; 衰减量平坦度: ±0.4 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 6; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.35

衰减量平坦度: 数值: ±0.4; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 8 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.3 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 8; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.3; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD固定衰减器裸芯片

衰减量: 10 dB; 输入/输出驻波比: 1.3 ; 衰减量平坦度: ±0.5 dB. 裸片尺寸: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

工作频率: 最小值: 0; 最大值: 30000; 数值: DC–30000; 单位: MHz

衰减量: 数值: 10; 单位: dB

输入/输出驻波比: 数值: 1.3

衰减量平坦度: 数值: ±0.5; 单位: dB

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。